

入射システム

高木 宏之 (物性研究所)

要求されるもの

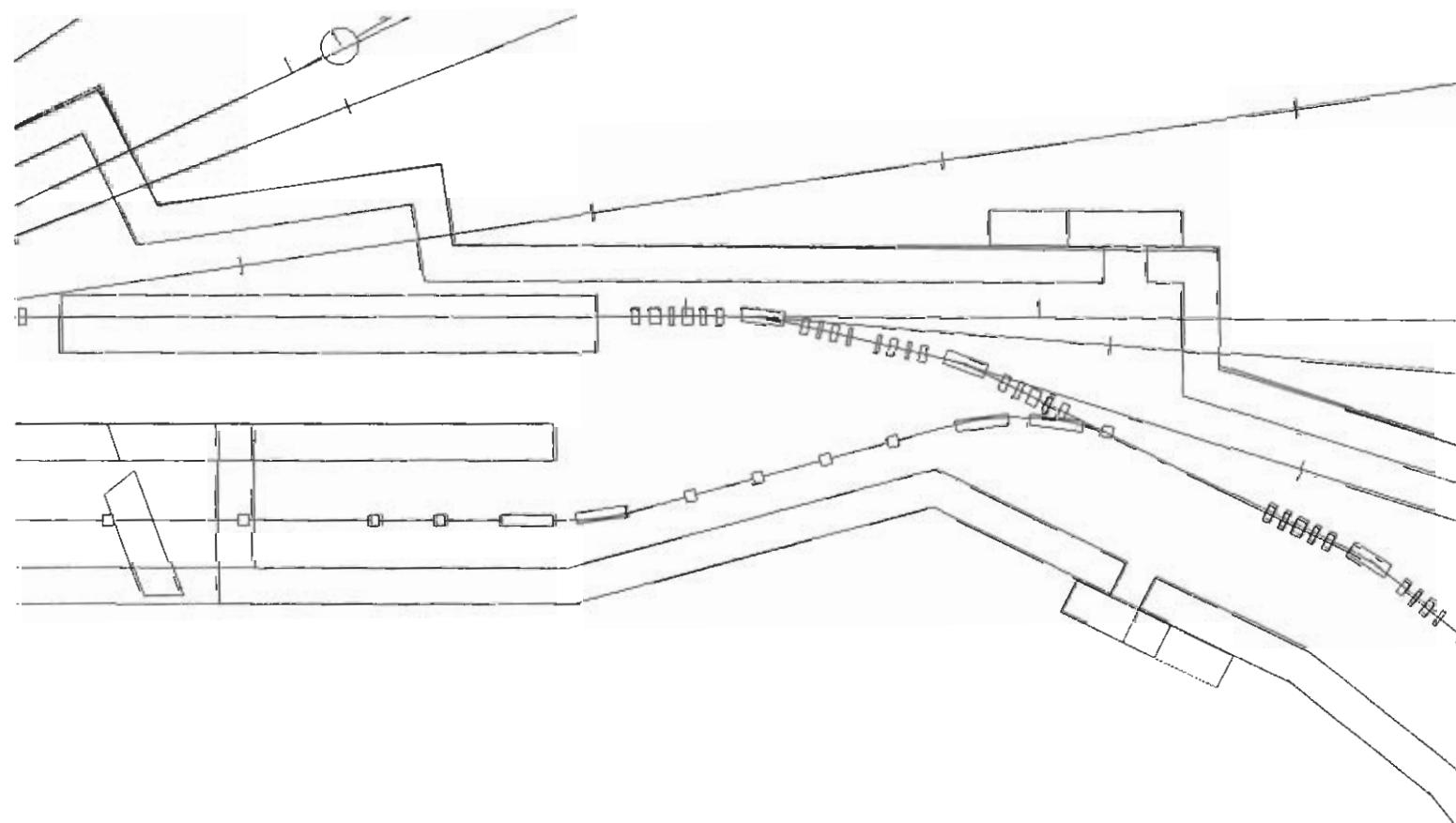
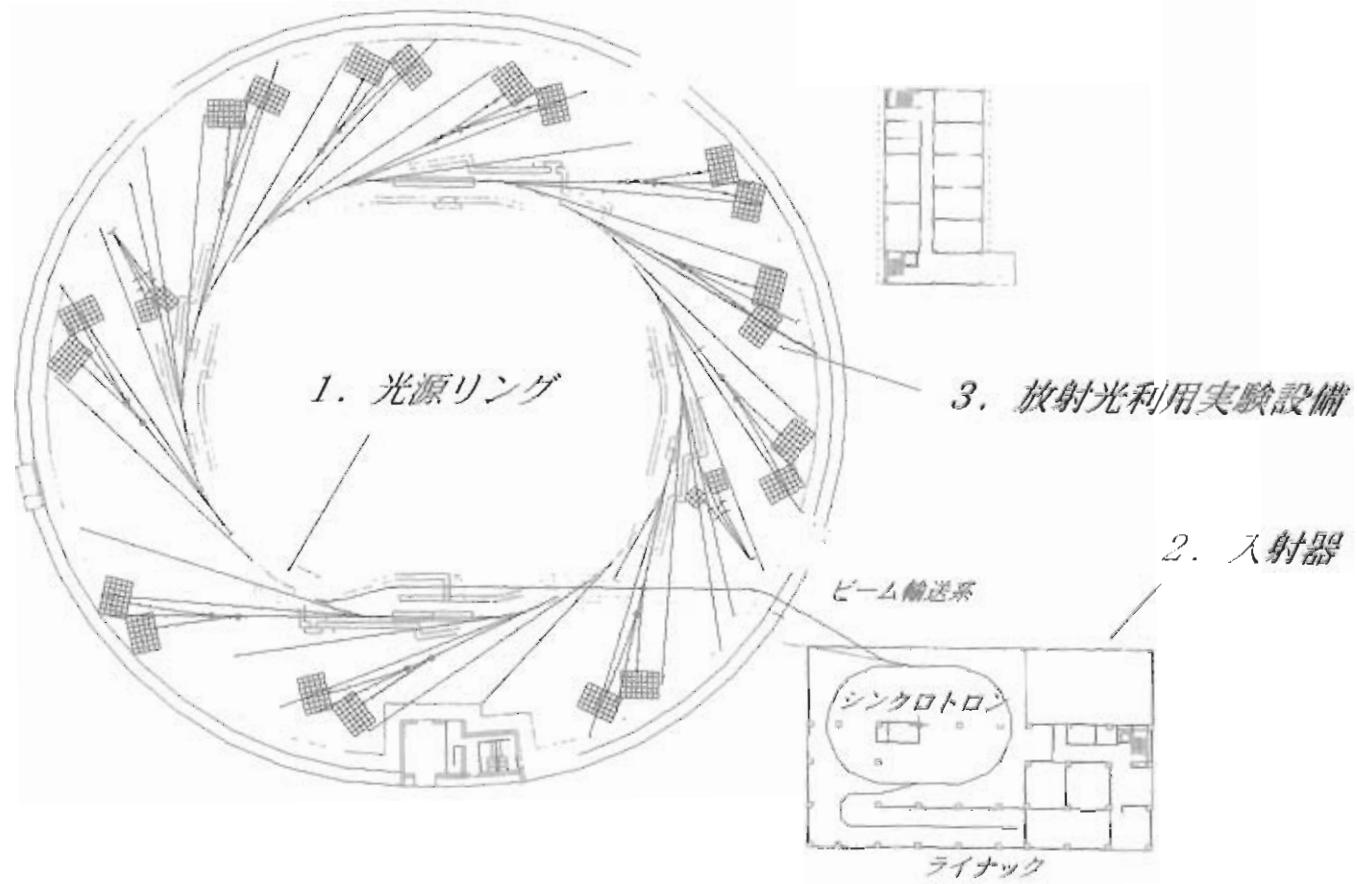
- マルチバンチ
 - セベラルバンチも含む
- シングルバンチ

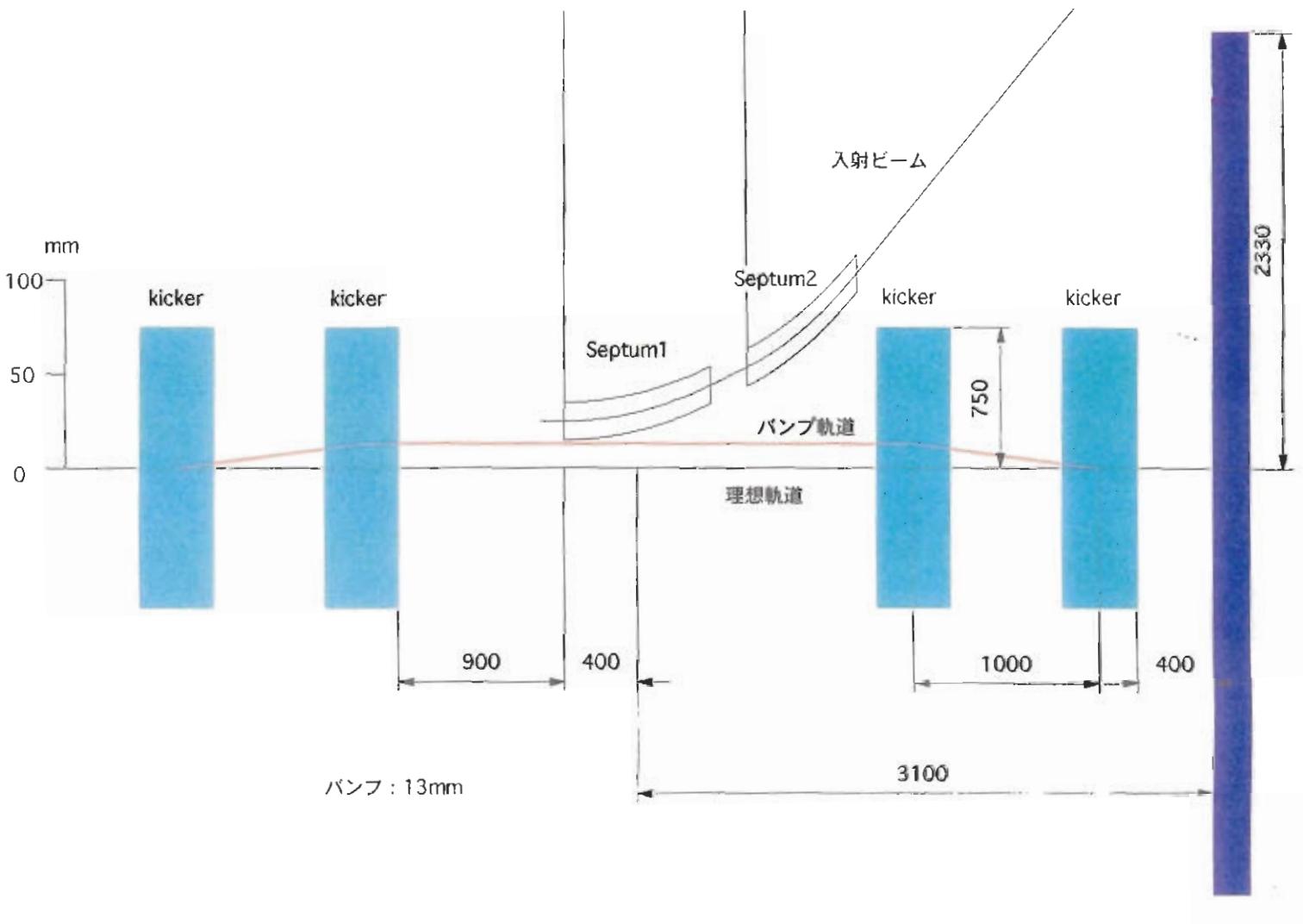
入射の繰返しは最大 1 Hz

これらのモードに対してトップアップ運転を可能にする

高輝度光源施設の概略図

4. 放射線安全研究・管理





キッカー

入射に必要なパンプ 13 mm
キッカー間の距離 1 m → 跳り角 13mrad

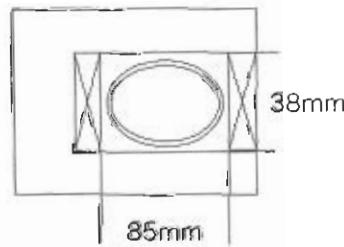
実効長を0.4 mとすると必要な磁場は0.22 [T]
(デザインノートの値0.36 [T]は厳しい)

キャップを38 mmとすると

$$NI = \frac{B}{\mu_0} = 7000 [\text{A}]$$

$$I := 3500 [\text{A}] \ (N=2) \\ = 7000 [\text{A}] \ (N=1)$$

$$L = 3.8 \ [\mu\text{H}] \ (N=2) \\ = 0.96 \ [\mu\text{H}] \ (N=1)$$



$$V = 23.2 [\text{kV}] \ (N=2) \\ = 11.7 [\text{kV}] \ (N=1)$$

これなら充電電圧25 kV以下で可能

セプタム電磁石

	パルスセプタム1	パルスセプタム2
電磁石長	0.8 m	0.6 m
磁極間隙長	15 mm	15 mm
最大磁場	0.4 T	0.8 T
電流	2500	2500
電流再現性・安定度	0.1%以下	0.1%以下
コイルターン数	2	4
運転	half-sine 40 μsec	half-sine 40 μsec

トップアップ入射と挿入光源磁石の減磁

リングに蓄積される電子数 N_0 (蓄積電流 400mA, 周回周期 935ns)

$$N_0 = \frac{0.4 \times 9.35 \times 10^{-7}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.34 \times 10^{12}$$

1日に損失する電子数 N_{loss} (入射効率 f , 寿命 τ_{life})

(1) 1日 n_{inj} 回入射 ($n_{inj} = 24/\tau_{life}$ と考えて)

$$N_{loss} = \frac{n_{inj} N_0}{f} = \frac{5.62 \times 10^{13}}{f \tau_{life} [\text{hrs}]}$$

(2) トップアップ入射

Δt の間に寿命により損失する電子数

$$\Delta N_{life} = \frac{N_0 \Delta t}{\tau_{life}}$$

これとこれを補う入射で損失する電子数の和

$$\Delta N_{loss} = \Delta N_{life} + \Delta N_{inj} = \frac{N_0 \Delta t}{f \tau_{life}}$$

1日当たりで損失する電子数

$$N_{loss} = \frac{24 N_0}{f \tau_{life} [\text{hrs}]} = \frac{5.62 \times 10^{13}}{f \tau_{life} [\text{hrs}]}$$

損失を抑える方法 (トップアップ入射・通常入射共に)

- ・入射効率を高める。
- ・ビーム寿命を長くする。

トップアップ入射では、放射光強度が一定になる一方で、ギャップを開じたまま入射するので、挿入光源磁石に照射される電子数は多くなる。

電子ビーム照射による永久磁石の減磁

飽和磁化 $B_s=1.18[\text{T}]$, 保磁力 $H_c=1420[\text{kA/m}]$ の磁石 (文献参照)

$n_e = 8.25 \times 10^{15} [\text{electrons/cm}^2]$ の照射 \rightarrow 5.6% の減磁

減磁の条件としてその 1/10 を考えると、

$$n_e \leq 8.75 \times 10^{14} [\text{electrons/cm}^2]$$

リング建設当初は、 $\tau_{life} < 1 \text{ hr}$ であり、 $f\tau_{life} < 1$ が暫く続く可能性がある。
この時、損失する電子の数は、

$$N_{loss} > 5.62 \times 10^{13} [\text{electrons}]$$

この場合、 N_{loss} がそのまま挿入光源の磁石 1cm^3 に照射されるとすると、
わずか 15 - 16 日で減磁が現れることになる。1 年で 200 日運転して、
20 年間 (約 4000 日) 磁石を交換しないで済むことが望ましい。

減磁を防ぐ方法

- ・ 入射効率を高める。
- ・ ビーム寿命 (特にガス散乱成分) を長くする。
- ・ 放射線への耐性が強い (保磁力の大きい) 磁石を選択する。
ただし、飽和磁化が一般に低いので、磁場は弱まる。
- ・ 磁石になるべく電子が照射されないような工夫を施す。
最小ギャップをあまり小さくせず、挿入光源以外の場所で電子損失
を起こさせる。ただし、100% 照射から逃れるのは難しい。

結論

- (1) トップアップ入射の御利益は、放射光強度一定であり、ギャップを小さくしても良いということではない。
- (2) トップアップ入射運転でもビーム寿命が長いことがビーム損失と挿入光源磁石の減磁の観点から必要となる。従って、一般にビーム寿命の短い極紫外・軟 X 線高輝度光源では十分な検討が必要である。

Top-up 入射の周期

- ・損失量

$$\frac{\Delta N_e}{N_e} = \frac{T_{top-up}}{\tau_{beamlife}}$$

I=400 mA の時、リングの電荷総量は $N_e = 374[nC]$

- ・1 バンチ当たりの電荷 0.8 nC の 1 / 20 を Top-up 入射
- ・1 バンチあたりの電荷の一様性を 5 % 以下に抑える
- ・入射効率を f とする

と入射の周期 T_{top-up} は

$$T_{top-up} = 1.07 \times 10^{-4} \tau_{beamlife} f$$

となり、 $N_{bunch}=468$ 、入射効率 100% としても

$$0.4 \text{ sec } (\tau_{beamlife}: 1 \text{ 時間})$$

$$4 \text{ sec } (\tau_{beamlife}: 10 \text{ 時間})$$

結論：

バンチごとの一様性を考慮する場合は、マルチバンチのトップアップが必要